

注意:考試開始鈴(鐘)響前,不可以翻閱試題本

100 學 年 度 技 術 校 院 二 年 制 統 一 入 學 測 驗 試 題 本

電子類、電機類

專業科目(一):電子學與電路學

【注 意 事 項】

- 1. 請核對考試科目與報考群(類)別是否相符。
- 2. 請檢查答案卡(卷)、座位及准考證三者之號碼是否完全相同,如有不符, 請監試人員查明處理。
- 3. 本試卷分兩部份, 共 40 題, 共 100 分, 答對給分, 答錯不倒扣。 第一部份(第 1 至 20 題, 每題 2.5 分, 共 50 分) 第二部份(第 21 至 40 題, 每題 2.5 分, 共 50 分)
- 4. 本試卷均為單一選擇題,每題都有(A)、(B)、(C)、(D) 四個選項,請選一個最適當答案,在答案卡同一題號對應方格內,用 2B 鉛筆塗滿方格,但不超出格外。
- 5. 有關數值計算的題目,以最接近的答案為準。
- 6. 本試卷空白處或背面,可做草稿使用。
- 7. 請在下欄方格內,填妥准考證號碼;考完後將「答案卡(卷)」及「試題本」一併繳回。

准考證號碼:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
考試開始鈴(鐘)響時,請先填寫准考證號碼,再翻閱試題本作答。

第1頁 共8頁

第一部份:電子學(第 1 至 20 題,每題 2.5 分,共 50 分)

1.	下列何者為三五族半導體之組成元素'	?
		•

- (A) 矽
- (B) 鍺
- (C) 氯化鈉
- (D) 砷化鎵
- 2. 超大型積體電路中,所謂 0.35 微米製程指的是 MOSFET 通道的:
 - (A) 最小長度
- (B) 最小高度
- (C) 最大寬度
- (D) 最大厚度
- 3. 有關主動濾波器及被動濾波器之敘述,下列何者錯誤?
 - (A) 主動濾波器一般採用主動元件搭配被動元件設計
 - (B) 被動濾波器不包含主動元件
 - (C) 主動濾波器可適用於低頻範圍之應用
 - (D)被動濾波器之最大電壓增益可大於1
- 4. 下列何種 FET 在製作時未事先製作通道?
 - (A) 空乏型 MOSFET

(B) 增強型 MOSFET

(C) N 通道 JFET

(D) P 通道 JFET

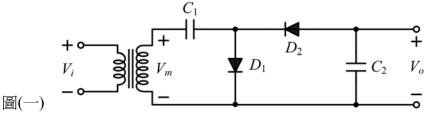
- 5. 下列何者為主動元件?
 - (A) 電阻器
- (B) 電容器
- (C) 電晶體
- (D) 電感器
- 6. 功率電晶體的集極與外殼通常接在一起,其主要目的為何?
 - (A) 美觀大方
- (B) 製造方便
- (C) 散熱較佳
- (D) 易於辨認
- 7. MOSFET 是以何種效應控制汲極與源極間之電流?
 - (A) 磁場效應
- (B) 電場效應
- (C) 光電效應
- (D) 霍爾效應

- 8. 由電晶體組成之振盪器,其必要條件為何?
 - (A) 同時含有電感及電容元件
- (B) 具有正回授

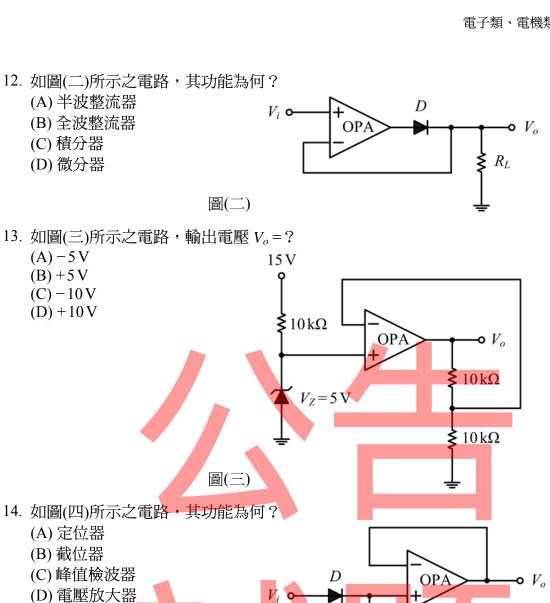
(C) 含有負電阻特性之元件

- (D) 含有壓電效應之元件
- 9. 有關 N 通道增強型 MOSFET 之敘述,下列何者正確?
 - (A) 輸出電阻與通道長度調變效應無關
 - (B) 臨界電壓與基體效應無關
 - (C) 閘極與源極間之電壓愈大, 汲極電流愈大
 - (D) 汲極電流與製程參數無關
- 10. 有一N通道空乏型 MOSFET 的汲極飽和電流 $I_{DSS} = 8 \,\text{mA}$,截止電壓 $V_{GS(\text{off})} = -4 \,\text{V}$,則 在 $V_{GS} = 0 \,\text{V}$ 的情況下,汲極電流 $I_D = ?$
 - (A) 8 mA
- (B) 10 mA
- (C) 12 mA
- (D) 16 mA

- 11. 如圖(-)所示之電路,輸出電壓 $V_o=?$
 - $(A) + V_m$
 - $(B) V_m$
 - $(C) + 2V_m$
 - (D) $-2V_{m}$



共8頁 第2頁



15. 如圖(五)所示之電路, V。之波形為何?

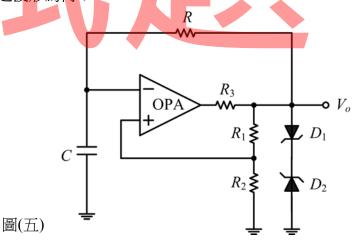
圖(四)



(B) 方波

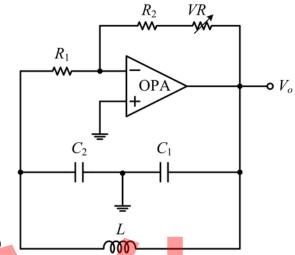
(C) 鋸齒波

(D) 弦波



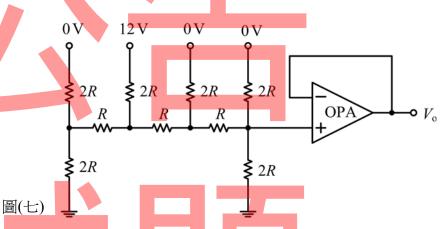
第3頁 共8頁

- 16. 如圖(六)所示之電路,此電路為哪一種振盪器?
 - (A) 考畢子振盪器
 - (B) 哈特萊振盪器
 - (C) RC 移相振盪器
 - (D) 韋恩電橋振盪器



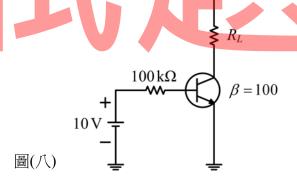
圖(六)

- 17. 如圖(七)所示之數位至類比轉換器電路,輸出電壓 $V_o=?$
 - (A) 0.25 V
 - (B) 0.5 V
 - (C) 1 V
 - (D) 2 V



+10 V

- 18. 如圖(八)所示之**電路,電**晶體導通<mark>時 $V_{BE} = 0.7$ V,飽和時 $V_{CE} = 0.2$ V</mark>,欲使電晶體工作於飽和區,則 R_L 最小值約為何?
 - (A) $8.27 k\Omega$
 - (B) $6.34 \text{ k}\Omega$
 - (C) $4.82 \text{ k}\Omega$
 - (D) $1.05 \text{ k}\Omega$

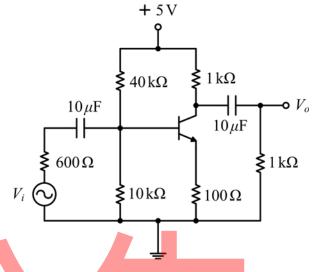


共8頁 第4頁

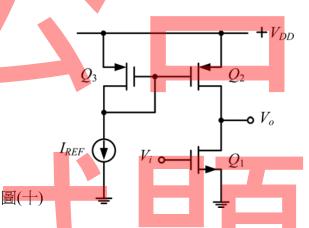
19. 如圖(九)所示之電路,設電晶體之β=200,則電壓增益約為何?

圖(九)

- (A) 1.2
- (B) 4.5
- (C) 10.8
- (D) 40.1



- 20. 如圖(十)所示之電路,若 $V_{DD}=3$ V, $I_{REF}=0.1$ mA, Q_1 、 Q_2 及 Q_3 之轉導 $g_m=10$ mA/V,輸出電阻 $r_o=20$ k Ω ,則電壓增益約為何?
 - (A) 100
 - (B) 200
 - (C) 400
 - (D) 600



第二部份:電路學(第21至40題,每題2.5分,共50分)

- 21. 兩電流 $i_1(t) = 3\cos(2t + 30^\circ)$ 安培及 $i_2(t) = -2\sin(3t + 30^\circ)$ 安培,則下列有關兩電流相位之敘述,何者正確?
 - (A) i₁(t)及i₂(t)同相位

- (B) i₁(t) 超前i₂(t) 之相角為60°
- (C) $i_1(t)$ 落後 $i_2(t)$ 之相角為90°
- (D) 兩電流相位無法比較
- 22. 將電壓源 $v(t) = 2\sin t$ 伏特與 1 亨利電感及 1 法拉電容串聯,則此串聯電路之特徵方程式 為何?
 - (A) $S^2 + 1 = 0$

(B) $S^2 + 2 = 0$

(C) $S^2 + S + 1 = 0$

- (D) $S^2 + 2S + 1 = 0$
- 23. 承接第 22 題,此串聯電路之諧振頻率為何?
 - (A) 0 rad/s
- (B) 1 rad/s
- (C) 2 rad/s
- (D) ∞ rad/s

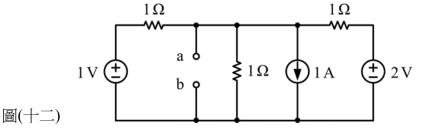
24.	某負載兩端電壓為 $v(t)=2+2\sqrt{2}\sin t$ 伏特,電流為 $i(t)=3+\sqrt{2}\sin(t-60^\circ)$ 安培, $v(t)$ 及 $i(t)$ 之有效值 (V_{ms}, I_{ms}) 為何?							
	$(A)(2V\cdot 3A)$	('rms 'rms) /\vi\langle	(B) (2V, 1A)					
	(C) $(\sqrt{8} \text{V} , \sqrt{10} \text{A})$		(D) $(\sqrt{10} \text{V} , \sqrt{8} \text{A})$					
25.	承接第 24 題,此負載 (A) 5 W	戏吸收之平均功率為何 (B) 6 W	? (C) 7 W	(D) 8 W				
26.		單位脈衝響應輸出為 3δ 此電路之網路函數(轉		(t) 分別為單位脈衝函數				
	(A) $3 + 2S$	$(B) \frac{1}{3+2S}$	$(C) \frac{S}{3S+2}$	$(D) \frac{3S+2}{S}$				
27.	某網路的輸出響應為	$\frac{2}{S(S^2+S+2)}$,則此輔	a 合出之穩態值為何?					
	(A) 0	(B) 1	(C) 2	(D) ∞				
28.	一雙埠網路以矩陣型	式表示為 $\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$egin{bmatrix} oldsymbol{V_1} \ oldsymbol{V_2} \end{bmatrix}$,					
	若改用傳輸參數矩陣	$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix} $	示,則下列選項何者」	E確?				
	(A) $A = -1 \coprod D = -2$ (C) $B = 1 \coprod C = -2$		(B) $B = 1 \perp C = 1$ (D) $A = 1 \perp B = 1$	•				
29.				生串聯共振・則電容器 <i>C</i>				
	(A) RC	(B) $\frac{C}{L}$	(C) $\frac{1}{R}\sqrt{\frac{C}{L}}$	(D) $\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$				
30.	如圖(十一)所示之電路 (A) 2 A	各,電流 i 為何?	1Ω 2Ω	1				
	(B) 1 A (C) -2 A		W	i				
	(D) -4 A	1 V 🛨	♦ i	⊋ 2 V				
		圖(十一)						
31.	承接第30題,1V電		(C) III-lik 2 W	(D) ##終 2W				
	(A) 供給 4W	(B) 吸收 1 W	(C) 吸收 2 W	(D) 供給 2 W				

共8頁 第6頁

32. 如圖(十二)所示之電路,若求 a、b 兩端之諾頓等效電路,則諾頓等效電流源為何?



- (B) 1 A
- (C) 2A
- (D) 3A

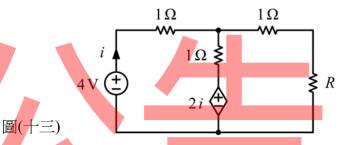


33. 承接第 32 題, a、b 兩端之等效電阻為何?

- (A) $0.33\,\Omega$
- (B) 1Ω
- $(C) 2\Omega$
- (D) 3Ω

34. 如圖(十三)所示之電路,若電阻 R 可獲得最大功率,則 R 值為何?

- (A) 5Ω
- (B) 4.25 Ω
- $(C) 2.5 \Omega$
- (D) 1.25Ω

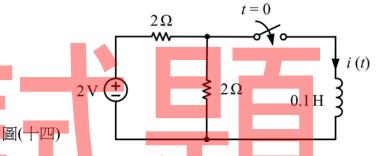


35. 承接第34題,電阻R可獲得之最大功率為何?

- (A) 0.5 W
- (B) 1.8 W
- (C) 4.2 W
- (D) 5.6 W

36. 如圖(十四)所示之電路,若 $i(0^-)=0$ A 且開關於t=0秒時閉合,則電路之時間常數為何?

- (A) 1 秒
- (B) 0.5 秒
- (C) 0.1 秒
- (D) 0.05 秒



37. 承接第 36 題,開關閉合後之*i(t)*為何?

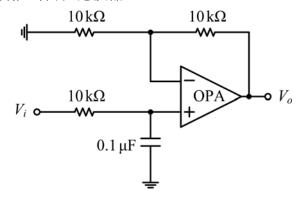
- (A) $1 e^{-10t}$ A
- (B) $2-2e^{-t}$ A

圖(十五)

- (C) $2 e^{-5t}$ A
- (D) $1-2e^{-2t}$ A

38. 如圖(十五)所示之電路,此電路功能為何種濾波器?

- (A) 帶拒濾波器
- (B) 帶通濾波器
- (C) 高通濾波器
- (D) 低通濾波器



【背面尚有試題】

第7頁 共8頁

- 39. 承接第38題,此濾波器之截止角頻率為何?
 - (A) 2000 rad/s
- (B) 1500 rad/s
- (C) 1000 rad/s (D) 500 rad/s
- 40. 如圖(十六)所示之雙埠網路,若其以矩陣型式表示為 $\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$,則下列敘述

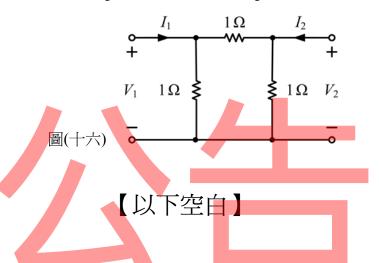
何者正確?

(A)
$$Z_{11} = \frac{3}{2}\Omega$$
 (B) $Z_{12} = \frac{1}{3}\Omega$ (C) $Z_{21} = \frac{2}{3}\Omega$ (D) $Z_{22} = 3\Omega$

(B)
$$Z_{12} = \frac{1}{3} \Omega$$

(C)
$$Z_{21} = \frac{2}{3} \Omega$$

$$(D)Z_{22} = 3\Omega$$





共8頁 第8頁

100 學年度技術校院二年制統一入學測驗 公告答案

考科代碼:2-01-1

類 別:電機類

考 科:電子學與電路學

題號	答案										
1	D	11	D	21	D	31	В	41		51	
2	А	12	А	22	А	32	С	42		52	
3	D	13	D	23	В	33	A	43		53	
4	В	14	C	24	С	34	D	44		54	
5	С	15	В	25	С	35	В	45		55	
6	С	16	А	26	D	36	С	46		56	
7	В	17	C	27	В	37	A	47		57	
8	В	18	D	28	А	38	P	48		58	
9	С	19	В	29	D	39	С	49		59	
10	А	20	А	30	С	40	В	50		60	